



第 28 回電子デバイス界面テクノロジー研究会 —材料・プロセス・デバイス特性の物理—

◇ 日時: 2023 年 2 月 3 日(金)~4 日(土)

◇ 場所: 東レ総合研修センター(〒411-0032 静岡県三島市末広町 24-21-9)

電子デバイスの性能向上・集積化・機能発現に向けて、その鍵を握る界面の基礎から応用までの幅広いテーマについて、実験と理論の両面から深く議論する研究会です。

プログラム

I チュートリアル講演

井上 史大 (横浜国立大学)

「前工程と後工程の垣根を超えた 3D 集積技術」

II 基調講演

川畑 史郎 (産業技術総合研究所)

「量子未来社会のための量子コンピュータ技術:基礎から最先端まで」

小池 淳義 (ウエスタンデジタルジャパン)

「TBA」

III 海外招待講演

TBA

IV 招待講演

吾郷浩樹 (九州大学)

「2次元物質から 2.5次元物質科学へ(仮)」

須賀 唯知 (東京大学/明星大学)

「先端 3D 集積技術としての表面活性化常温接合」

田中 啓安 (キオクシア株式会社)

「BiCS(3D-Flash メモリ)技術の現状と展望(仮)」

浜井 貴将(キオクシア株式会社)

「HfO-FeFET の動作メカニズム解析」

V 企画セッション

“カーボンニュートラルに貢献する半導体産業”

パネリストなど詳細は決まり次第 HP に掲載いたします。

- **参加費:** 薄膜・表面物理分科会員 17,000 円、応用物理学会員・協賛学協会員 21,000 円、学生・シニア 10,000 円、その他 26,000 円
- **参加申込方法:** <http://edit-ws.jp/registration.html> (2022 年 11 月中に開始予定)
- **問合せ先:**
電子デバイス界面テクノロジー研究会事務局
registration@edit-ws.jp
<http://edit-ws.jp/index.html>